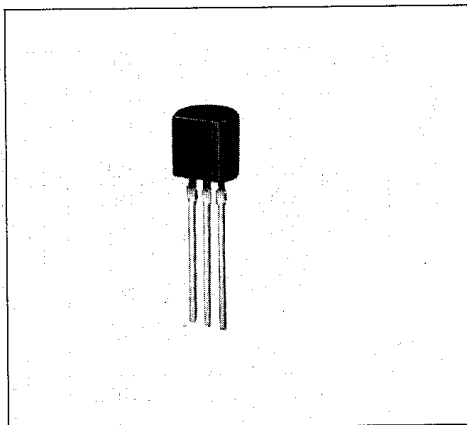
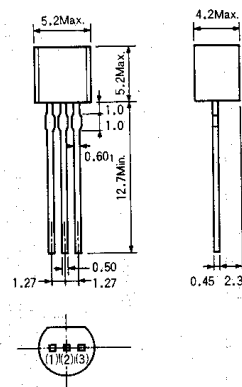


エピタキシャルプレーナ形 NPNシリコントランジスタ

2SD786



●外形寸法図



(単位:mm)

図1 JEDEC: TO-92
EIAJ: SC-43

MCカートリッジ用のヘッドアンプに最適な超低雑音トランジスタです。

●特長

1) 超低雑音である (低 R_g での雑音特性がよい)
 $NF=2.5dB$ Typ.

(at $f=10Hz$, $R_g=10\Omega$, $V_{CE}=6V$,
 $I_C=3mA$)

$NF=1.0dB$ Typ.

(at $f=10Hz$, $R_g=100\Omega$, $V_{CE}=6V$,
 $I_C=0.5\sim 2mA$)

2) $r_{bb'}$ が 4Ω と少ない。

3) 電圧性雑音が少ない。

$e_n=0.55nV/\sqrt{Hz}$ (at 10Hz, 10mA)

4) 2SB737とのペアで超高性能ヘッドアンプが可能。

●用途

MC/MM用ヘッドアンプ

低インピーダンス入力回路用ヘッドアンプ

●絶対最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

項 目	記 号	最大定格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	300	mA
コレクタ損失	P_C	250	mW
接合部温度	T_J	125	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$-55\sim 125$	$^\circ C$

●電氣的特性 ($T_a=25^\circ C$)

項 目	記 号	Min.	Typ.	Max.	単位	条 件
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CE0}	40	—	—	V	$I_C=1mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CB0}	50	—	—	V	$I_C=50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EB0}	5	—	—	V	$I_E=50\mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	—	—	0.5	μA	$V_{CB}=30V$
エミッタシャ断電流	I_{EB0}	—	—	0.5	μA	$V_{EB}=4V$
直流電流増幅率	h_{FE}	120	—	560	—	$V_{CE}/I_C=6V/10mA$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	0.03	0.5	V	$I_C/I_B=50mA/5mA$
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f_T	—	100	—	MHz	$V_{CE}=6V$, $I_E=-10mA$
ベース拡がり抵抗	$r_{bb'}$	—	4	6	Ω	$V_{CE}=6V$, $I_C=1mA$, $f=30MHz$
実効値雑音電圧	NV_i	—	—	150	mV	FLAT AMP ($G_v=80dB$) $V_{CE}=10V$, $I_C=1mA$ $R_g=100k\Omega$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

アイテム	Q	R	S
h_{FE}	120~270	180~390	270~560